

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ОРИОН»
(ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»)

РАССМОТREНО
на заседании
Экспертного совета
ГАУ ДО ВО «Региональный центр
«Орион»
Протокол № 8
от «03» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАУ ДО ВО «Региональный центр
«Орион»

Илья Голева



«Основы Электроники»
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

Направленность: техническая
Профиль: математика
Тип программы: модифицированная
Возраст участников программы: 14 – 18 лет
Срок реализации программы: полгода (72 часа)
Уровень освоения: базовый

г. Воронеж, 2020 г.

**Пояснительная записка
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Основы электроники»**

В настоящее время невозможно найти какую-либо отрасль промышленности, в которой не использовались бы электронные приборы или электронные устройства измерительной техники, автоматики и вычислительной техники. На базе новых эффектов (явлений) создаются электронные устройства

Выделяют физическую электронику, имея в виду раздел физики, рассматривающий электропроводимость тел, контактные и термоэлектронные явления. Под технической электроникой понимают те ее разделы, в которых описываются устройства приборов и аппаратов и схемы их включения. Полупроводниковой электроникой называют то, что относится к применению полупроводниковых приборов, и т. п.

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы электроники» предназначена для учащихся, проявляющих особый интерес к полупроводниковой электронике. Рассмотрены принципы функционирования, математические модели, основные параметры и характеристики диодов, биполярных и полевых транзисторов, операционных усилителей, а так же схемы включения элементов в электронных схемах.

Основополагающими для разработки программы стали следующие нормативные документы:

- Закон об образовании в РФ. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Концепция развития дополнительного образования детей» (утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПин 2.4.4.31 74-14 (Постановление от 04.07.2014 г.).
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения дополнительного образования детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4 3598-20 (Постановление от 30.06.2020 г.).
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо

Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.15 г.).

- Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (приказ директора № 226 от 29.12.2019г).
- Устав ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (новая редакция), утвержденный департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 24.09.2019 г. №1125).

Область деятельности учащегося включает математику и электронику.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Основы электроники» состоит в том, что она позволяет познакомиться учащимся с принципами функционирования, математическими моделями, основными параметрами и характеристиками диодов, биполярных и полевых транзисторов, операционных усилителей, а так же схемы включения элементов в электронных схемах.

Новизна программы «Основы электроники» опирается на приобретение знаний в области схемотехнического проектирования электронных устройств.

Цель:

- знакомство с принципами работы основных электронных устройств, формирование навыков расчетов, экспериментальных исследований, проектирования и разработки принципиальных электрических схем с использованием современных средств вычислительной техники и новых информационных технологий.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, повысить конкурентоспособность в проектной деятельности.

Задачи программы:

1. Образовательные:

- расширить познавательный интерес к изучаемым разделам программы;
- актуализировать изучение характеристик и параметров полупроводниковых приборов;
- изучить назначение и характеристики базовых элементов и основных функциональных узлов электронных схем;
- создать условия для усвоения принципов и подходов;
- сформировать систему знаний, умений и навыков в области методик решения прикладных задач в различных предметных областях;
- обеспечить формирование основополагающих компетенций учащихся.

2. Развивающие:

- содействовать развитию личностного самообразования учащихся через

участие в практической деятельности;

- познакомить учащихся с методами расчета и проектирования устройств.

3. Воспитательные:

- способствовать формированию ответственного отношения к своей деятельности;

- содействовать социальной адаптации и самоопределению талантливой молодежи;

- создать условия для профессиональной ориентации учащихся.

Срок реализации программы: полгода. Программа рассчитана на 72 часа.

Формы учебной деятельности:

- лекции, практические занятия;

- индивидуальные консультации;

- самостоятельные работы в малых группах.

Учащиеся осваивают следующие типы деятельности: исследовательский, творческий, проектный, практический, а также познавательный, информационно-коммуникативный и рефлексивный.

В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Основы электроники» применяются следующие формы обучения: индивидуально-обособленная (когда материал доступен для самостоятельного обучения) и коллективная (когда у всех учащихся одна цель).

В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Основы электроники» применяются следующие методы:

- по источнику знаний (словесные, наглядные, практические);

- по степени взаимодействия педагога и учащегося (изложение, беседа, самостоятельная работа);

- по дидактическим задачам (подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала);

- по характеру познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский).

Основные критерии отбора обучающихся для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе являются:

- участие в процедуре конкурсного отбора (в виде вступительного испытания).

Возраст: группы учащихся смешанные 14-18 лет.

Количество учащихся: 15 человек для теоретических занятий, 15 человек для практических занятий.

Состав группы: постоянный, разновозрастный.

Форма занятий: индивидуально-групповая, с использованием элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Количество занятий: теоретические занятия – 2 часа по 45 минут, практические занятия – 2 часа по 45 минут.

Учащийся в ходе освоения дополнительной обще развивающей программы должен решать следующие **задачи**:

- изучение характеристик и параметров полупроводниковых приборов;
- приобретение знаний в области схемотехнического проектирования электронных устройств;
- участие в выполнении учебных исследований, анализ их результатов и формулировка выводов.

Ожидаемые результаты освоения программы:

К концу обучения и воспитания по дополнительной обще развивающей программе учащиеся приобретут комплекс взаимосвязанных знаний, представлений, умений, определенный опыт.

1. Личностные результаты:

- саморазвитие, самореализация;
- личностное самоопределение по выбору будущей профессии, социализация.

2. Метапредметные результаты:

- освоение основных методик учебно-исследовательской деятельности;
- освоение навыка работы с инструкцией и следования ей;
- сформированность следующий **компетенций**:

- Общекультурных:

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- стремлением к саморазвитию и адаптации к жизни;
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества.

- Профессиональных:

- способностью применять методы построения нейронных сетей в процессе решения прикладных задач;
- готовностью использовать современные информационные технологии;
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;
- готовностью к изучению научно-технической информации, нестандартных подходов к решению поставленных задач.

- Регулятивные:

- учащийся получит возможность научиться самостоятельно определять цели и оценивать свои возможности их достижения;

- учащийся научится самостоятельно анализировать достижение поставленной цели.

- Коммуникативные:

- учащийся научится задавать вопросы и осуществлять взаимный контроль;

- учащийся получит возможность научиться последовательно и полно усваивать необходимую информацию.

- Познавательные:

- учащийся научится проводить практические и лабораторные работы под руководством педагога дополнительного образования;

- учащийся получит возможность научиться проходить весь цикл использования нейронных сетей от процесса анализа исходных данных задачи до процесса принятия решений на основе анализа полученных результатов.

3. Предметные результаты:

К концу обучения:

3.1. Учащийся должен знать:

- назначение и характеристики базовых элементов и основных функциональных узлов электронных схем;

- знать принципы построения электронных схем.

3.2. Учащийся должен уметь:

- читать принципиальные электрические схемы электронных устройств;

- выбирать тип элементов по назначению;

- рассчитывать и проектировать принципиальные электрические схемы.

3.3. В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы «Основы электроники» учащийся должен владеть:

- рассчитывать и проектировать принципиальные электрические схемы.

Форма аттестации учащихся на соответствие их персональных достижений требованиям, соответствующих дополнительной общеразвивающей программы «Основы электроники» состоит из прохождения тестов содержащего теоретические вопросы и практические задачи.

Этапы педагогического контроля:

1 – итоговый (проводится по окончании обучения, в виде тестирования).

Контрольно-измерительные материалы: критерии оценки итогового проекта учащихся.

Критерием эффективности реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы электроники» является востребованность полученных знаний обучающихся.

Материально-техническое обеспечение.

- проектор, мышь, экран, интерактивная доска;
- методическое пособие по выполнению практических заданий;
- конспект лекций.

**Учебный план
дополнительной общеразвивающей программы
«Основы электроники»**

№	Наименование темы	Кол-во часов		
		теория	практика	итого
1	Базовые элементы аналоговых и цифровых устройств	4	4	8
2	Общая характеристика и параметры полупроводниковых приборов	6	6	12
3	Электронные усилители.	6	18	24
4	Фильтры	4	12	16
5	Генераторы.	6	4	10
6	Итоговая аттестация.	0	2	2
Итого:		26	46	72

**Методическое обеспечение
дополнительной общеразвивающей программы
«Основы электроники»**

- поурочное планирование теоретических и практических занятий;
- подобранный и обобщенный материал по темам занятий;
- разработки методических рекомендаций и памяток;
- методические пособия для практических занятий по темам программы.

**Содержание
дополнительной общеразвивающей программы
«Основы электроники»**

1. Базовые элементы аналоговых и цифровых устройств (6 часов).

1.1. Теория (4 ч).

Техника безопасности. Входной контроль. Общие понятия электроники. Понятие радиоэлектронного элемента, устройства, функциональной группы (2 ч).

Резисторы. Конденсаторы. Индуктивности и трансформаторы (2 ч).

1.2. Практика (2 ч)

Изучение пакета Multisim Live (2 ч).

Резисторы. Конденсаторы. Индуктивности и трансформаторы. Их электрические характеристики и основные схемы соединения (2 ч).

2. Общая характеристика и параметры полупроводниковых приборов (14 ч).

2.1. Теория (6 ч).

Понятие полупроводников. Принцип действия и классификация полупроводниковых приборов. (2 ч).

Диоды. Вольтамперные характеристики диодов (2 ч).

Биполярные транзисторы. Физические процессы в транзисторах. Схемы включения транзистора. Н-параметры транзисторов (2 ч).

2.2. Практика (8 ч)

Определение статического коэффициента передачи тока транзистора (2 ч).

Определение выходных характеристик транзистора (2 ч).

Исследование схемы транзисторного ключа (2 ч).

3. Применение уравнений к решению задач (24 часов).

3.1. Теория (6 ч).

Классификация усилителей. Основные характеристики усилителей (2 ч).

Статический режим работы усилительных каскадов (2 ч).

Однокаскадные усилители (2 ч).

3.2. Практика (18 ч)

Изучение функционирования усилительного каскада с общим эмиттером (2 ч).

Исследование влияния нагрузки усилительного каскада с общим эмиттером на режим работы усилительного каскада на коэффициент усиления по напряжению (току, мощности) (2 ч).

Исследование зависимости амплитудно-частотной характеристики от частоты входного сигнала усилительного каскада с общим эмиттером (2 ч).

Изучение функционирования усилительного каскада с общей базой (2 ч).

Исследование влияния нагрузки усилительного каскада с общей базой на режим работы усилительного каскада на коэффициент усиления по напряжению (току, мощности) (2 ч).

Исследование зависимости амплитудно-частотной характеристики от частоты входного сигнала усилительного каскада с общей базой (2 ч).

Изучение функционирования усилительного каскада с общим коллектором (2 ч).

Исследование влияния нагрузки усилительного каскада с общим коллектором на режим работы усилительного каскада на коэффициент усиления по напряжению (току, мощности) (2 ч).

Исследование зависимости амплитудно-частотной характеристики от частоты входного сигнала усилительного каскада с общим коллектором (2 ч).

4. Фильтры (16 часов).

4.1. Теория (4 ч).

Фильтры электрических сигналов и их характеристики (2 ч). Активные фильтры. Основные свойства. Схемы активных фильтров (2 ч).

4.2. Практика (12 ч).

Расчет частотных характеристик фильтров (ФНЧ и ПФ) (2 ч).

Расчет переходных процессов в фильтрах (ФНЧ и ПФ) (2 ч).

Расчет частотных характеристик при вариации параметров (ФНЧ и ПФ) (2 ч).

Расчет частотных характеристик фильтров (ФВЧ и РФ) (2 ч).

Расчет переходных процессов в фильтрах (ФВЧ и РФ) (2 ч).

Расчет частотных характеристик при вариации параметров (ФВЧ и РФ) (2 ч).

4. Генераторы (10 часов).

4.1. Теория (6 ч).

Генераторы электрических колебаний и их основные схемы (2 ч).

Генераторы напряжения заданной формы. Мультивибраторы (2 ч).

Кварцевые генераторы (2 ч).

4.2. Практика (4 ч).

Построение схемы релаксационного генератора с заданной частотой генерации (2 ч).

Исследование зависимости частоты генерации от постоянной времени (2 ч).

5. Итоговая аттестация (2 часа).

Контрольная работа. Подведение итогов (2 ч).

Литература для педагогов

1. Воробьев Н.И. Проектирование электронных устройств / Н.И. Воробьев – М.: Высшая школа, 1989. – 223 с.
2. Гринфилд Д. Транзисторы и линейные ИС / Д. Гринфилд — М.: Мир, 1992
3. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем / И.П. Степаненко - М.: Энергия, 1973. – 608 с.
4. Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк – М.: Мир, 1982. – 512 с.
5. Хоровиц П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл — М.: Мир, 1993.
6. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС / Л. Фолкенберри — М.: Мир, 1985. – 572 с.
7. Новикова Е.И. Основы электроники и микропроцессорной техники: учеб. пособие / Е.И. Новикова, О.В. Родионов. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2012. 178 с.

Литература для учащегося

1. Воробьев Н.И. Проектирование электронных устройств / Н.И. Воробьев – М.: Высшая школа, 1989. – 223 с.
2. Гринфилд Д. Транзисторы и линейные ИС / Д. Гринфилд — М.: Мир, 1992
3. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем / И.П. Степаненко - М.: Энергия, 1973. – 608 с.
4. Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк – М.: Мир, 1982. – 512 с.

Контрольно-измерительное задание

1. Полупроводниковые приборы с двумя или несколькими взаимодействующими электрическими р-п-переходами и тремя выводами или более, усиливательные свойства которых обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда.

- а) биполярный транзистор,
- б) полупроводниковый диод,
- в) вариакап,
- г) полевой транзистор.

2. Полупроводниковые приборы, в которых регулирование тока производится изменением проводимости проводящего канала с помощью электрического поля, перпендикулярного направлению тока.

- а) биполярный транзистор,
- б) полупроводниковый диод,
- в) вариакап,
- г) полевой транзистор.

3. Зависимость угла сдвига фазы между выходным и входным напряжениями от частоты

- а) амплитудно-частотная характеристика,
- б) фазо-частотная характеристика,
- в) амплитудно-фазовая характеристика,
- г) амплитудная характеристика.

4. Зависимость амплитудного значения напряжения первой гармоники выходного напряжения от амплитуды синусоидального входного напряжения.

- а) амплитудно-частотная характеристика,
- б) фазо-частотная характеристика,
- в) амплитудно-фазовая характеристика,
- г) амплитудная характеристика.

5. Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты входного сигнала.

- а) амплитудно-частотная характеристика,
- б) фазо-частотная характеристика,
- в) амплитудно-фазовая характеристика,
- г) амплитудная характеристика.

6. Режим, при котором один из переходов биполярного транзистора смешен в прямом направлении приложенным к нему внешним напряжением, а другой — в обратном направлении.

- а) активный,
- б) отсечки,
- в) насыщения.

7. У эмиттерного повторителя коэффициентом усиления

- а) по напряжению =1,
 б) по току $K=1$,
 в) по мощности $K=1$.

8. Коэффициент передачи по току биполярных транзисторов

а) $h_{11} = \frac{U_{B\Theta}}{I_B} \Big|_{U_{K\Theta}=0}$,

б) $h_{12} = \frac{U_{B\Theta}}{U_{K\Theta}} \Big|_{I_B=0}$,

в) $h_{21} = \frac{I_K}{I_B} \Big|_{U_{K\Theta}=0}$,

г) $h_{22} = \frac{I_\Theta}{U_{K\Theta}} \Big|_{I_B=0}$.

9. Коэффициент обратной связи по напряжению биполярных транзисторов

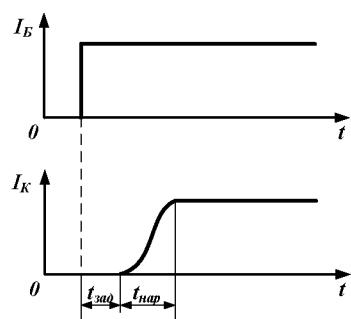
а) $h_{11} = \frac{U_{B\Theta}}{I_B} \Big|_{U_{K\Theta}=0}$,

б) $h_{12} = \frac{U_{B\Theta}}{U_{K\Theta}} \Big|_{I_B=0}$,

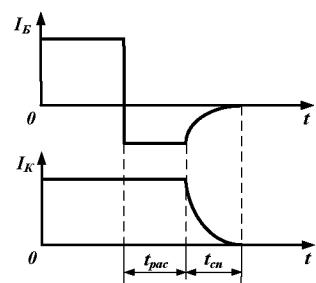
в) $h_{21} = \frac{I_K}{I_B} \Big|_{U_{K\Theta}=0}$,

г) $h_{22} = \frac{I_\Theta}{U_{K\Theta}} \Big|_{I_B=0}$.

10 Процессы включения транзисторного ключа

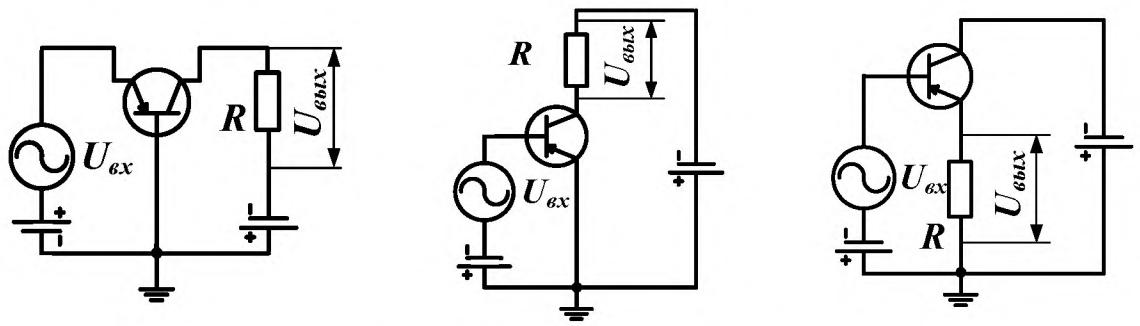


a)

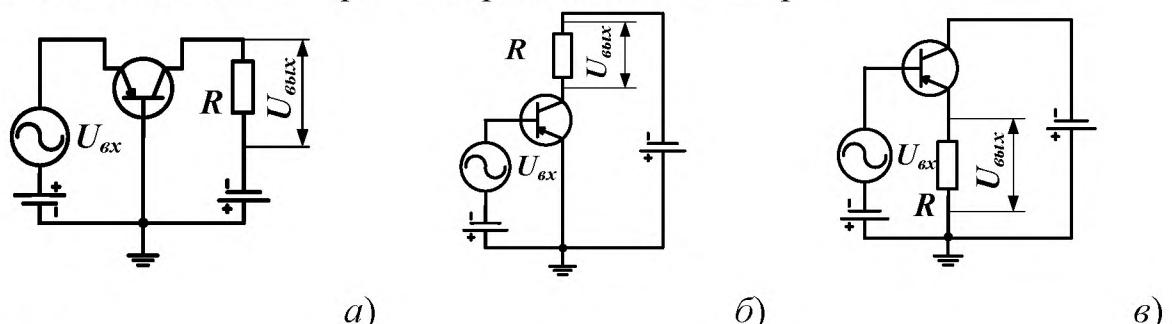


б)

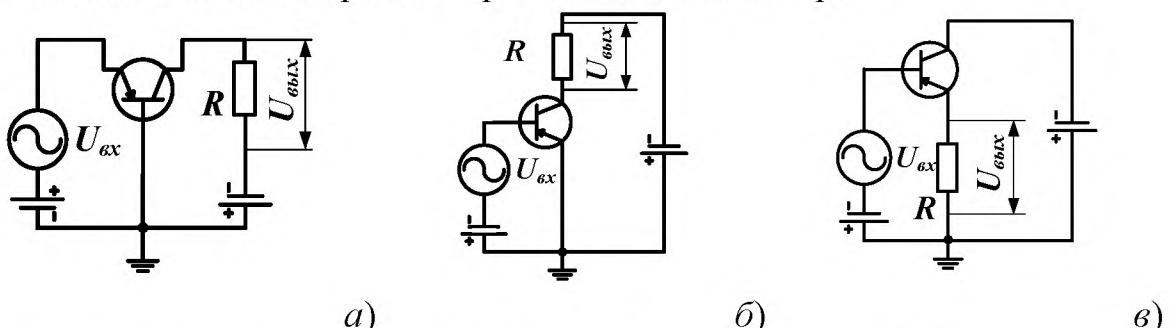
11. Схема включения транзистора с общей базой



12. Схема включения транзистора с общим эмиттером



13. Схема включения транзистора с общим коллектором



14. Выходные характеристики транзистора, включенного по схеме с ОЭ

